

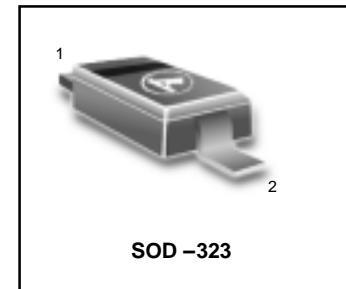
Switching Diode

FEATURE

- Small plastic SMD package.
- Continuous reverse voltage: max. 75 V.
- High-speed switching in hybrid thick and thin-film circuits.
- Pb-Free Package is available.

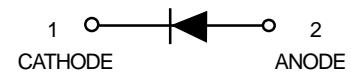
DEVICE MARKING AND ORDERING INFORMATION

Device	Marking	Shipping
LBAS16HT1	A6	3000/Tape&Reel
LBAS16HT1G	A6 (Pb-Free)	3000/Tape&Reel

LBAS16HT1


MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Continuous Reverse Voltage	V _R	75	Vdc
Peak Forward Current	I _F	200	mAdc
Peak Forward Surge Current	I _{FM(surge)}	500	mAdc



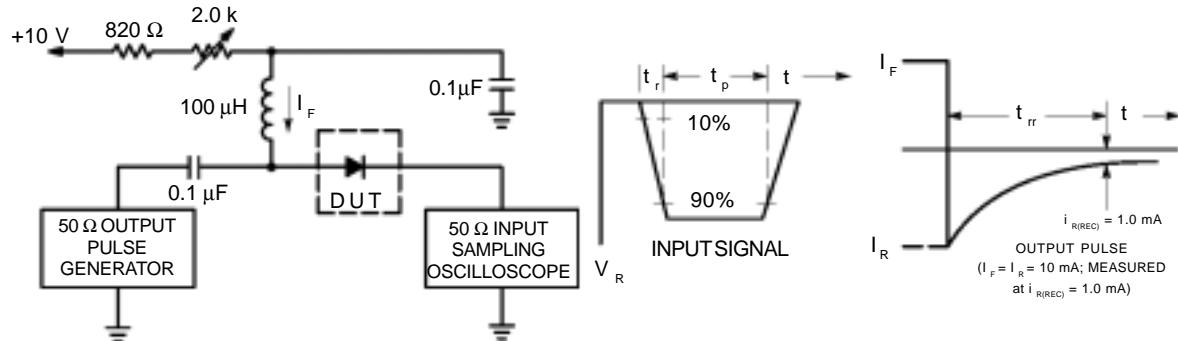
THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Total Device Dissipation FR-5 Board,* TA = 25°C	P _D	200	mW
Derate above 25°C		1.57	mW/°C
Thermal Resistance Junction to Ambient	R _{θJA}	635	°C/W
Junction and Storage Temperature	T _J , T _{stg}	150	°C

*FR-4 Minimum Pad

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Reverse Voltage Leakage Current (V R = 75 Vdc)	I _R	—	1.0	μAdc
(V R = 75 Vdc, T J = 150°C)		—	50	
(V R = 25 Vdc, T J = 150°C)		—	30	
Reverse Breakdown Voltage (I _{BR} = 100 μAdc)	V _(BR)	75	—	Vdc
Forward Voltage (I F = 1.0 mAdc)	V _F	—	715	mV
(I F = 10 mAdc)		—	855	
(I F = 50 mAdc)		—	1000	
(I F = 150 mAdc)		—	1250	
Diode Capacitance (V R = 0, f = 1.0 MHz)	C _D	—	2.0	pF
Forward Recovery Voltage (I F = 10 mAdc, t _r = 20 ns)	V _{FR}	—	1.75	Vdc
Reverse Recovery Time (I F = I _R = 10 mAdc, R L = 50 Ω)	t _{rr}	—	6.0	ns
Stored Charge (I F = 10 mAdc to V R = 5.0 Vdc, R L = 500 Ω)	Q _S	—	45	pC

LBAS16HT1


Notes: 1. A 2.0 k Ω variable resistor adjusted for a Forward Current (I_F) of 10mA.
 2. Input pulse is adjusted so $I_{R(\text{peak})}$ is equal to 10mA.
 3. $t_p \gg t_{rr}$

Figure 1. Recovery Time Equivalent Test Circuit

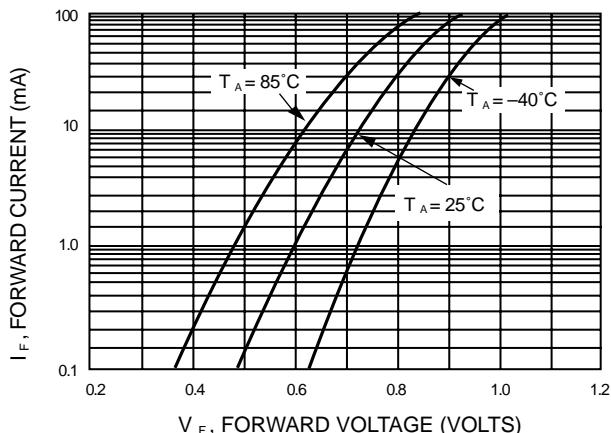
TYPICAL CHARACTERISTICS


Figure 2. Forward Voltage

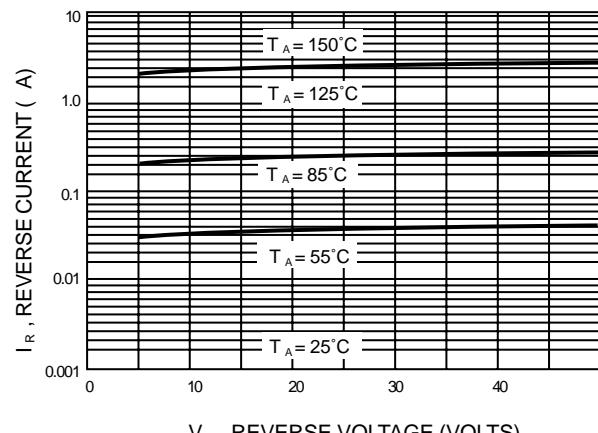


Figure 3. Leakage Current

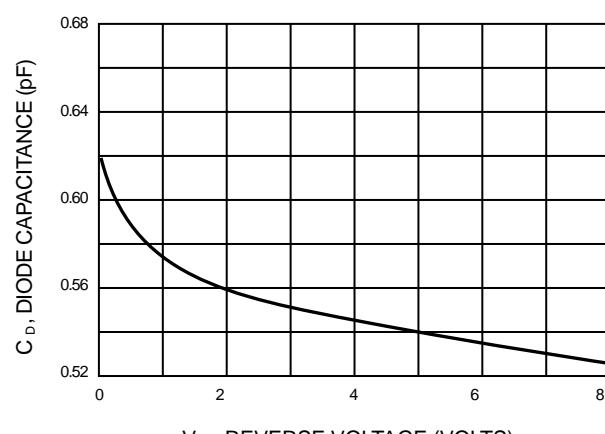
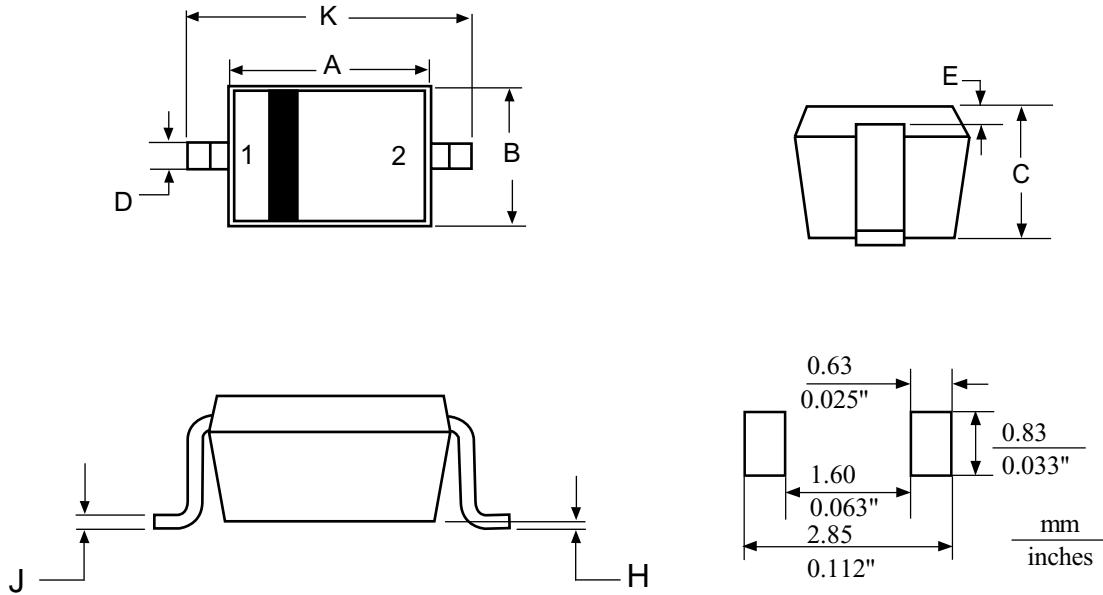


Figure 4. Capacitance

LBAS16HT1
SOD-323

NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING
PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.60	1.80	0.063	0.071
B	1.15	1.35	0.045	0.053
C	0.80	1.00	0.031	0.039
D	0.25	0.40	0.010	0.016
E	0.15 REF		0.006 REF	
H	0.00	0.10	0.000	0.004
J	0.089	0.177	0.0035	0.0070
K	2.30	2.70	0.091	0.106

 PIN:1:CATHODE
 2:ANODE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.